
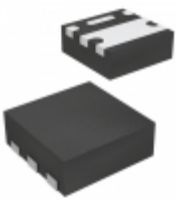






	<h2>SIA426DJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA426DJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 4.5A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA426DJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18868 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA426DJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 4.5A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18868 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23.6 mOhm @ 9.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1020pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SIA426DJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA426DJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA426DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA426DJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA427ADJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 12A 6SC-70</p>	 <p>SIA427DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 12A SC-70-6</p>	 <p>SIA425EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.5A SC-70-6</p>	 <p>SIA427ADJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 12A 6SC-70</p>
 <p>SIA427DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 12A SC-70-6</p>	 <p>SIA426DJ Original</p>	 <p>SIA421DJ-T1-GE3 Vishay / Spectrol MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA427ADJ-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIA400EDJ-T1-GE3	↔ SIA402DJ-T1-E3	⇒ SIA406DJ-T1-GE3	D SIA406DJ-T1-GE3	⇒ SIA408DJ-T1-GE3
⊣ SIA408DJ-T1-GE3	⊛ SIA411DJ-T1-GE3	D SIA411DJ-T1-GE3	⇒ SIA413DJ-T1-GE3	⇒ SIA413DJ-T1-GE3
⊛ SIA413DJ-T4-GE3	⊣ SIA414DJ-T1-GE3	⊛ SIA414DJ-T1-GE3	↔ SIA415DJ-T1-GE3	⇒ SIA415DJ-T1-GE3
D SIA417DJ-T1-GE3	⊛ SIA417DJ-T1-GE3	⊣ SIA419DJ	⊛ SIA419DJ-T1-GE3	⇒ SIA419DJ-T1-GE3
⇒ SIA421DJ-T1-GE3	↔ SIA421DJ-T1-GE3	⊛ SIA425EDJ-T1-GE3	⊣ SIA425EDJ-T1-GE3	⇒ SIA426DJ-T1-GE3
↔ SIA427DJ-T1-GE3	⇒ SIA427DJ-T1-GE3	D SIA429DJ-T1-GE3	⊛ SIA429DJ-T1-GE3	⊣ SIA430DJ-T1-GE3
⊛ SIA430DJ-T1-GE3	D SIA431DJ	⇒ SIA431DJ-T1	↔ SIA431DJ-T1-GE3	⇒ SIA431DJ-T1-GE3
⊣ SIA432DJ-T1-GE3	⊛ SIA432DJ-T1-GE3	↔ SIA433EDJ	⇒ SIA433EDJ-T1-GE3	⇒ SIA433EDJ-T1-GE3
⊛ SIA436DJ-T1-GE3	⊣ SIA436DJ-T1-GE3	⊛ SIA443DJ-T1-GE3	D SIA443DJ-T1-GE3	⇒ SIA444DJ-T1-GE3
↔ SIA444DJ-T1-GE3	⊛ SIA445EDJ-T1-GE3	⊣ SIA445EDJ-T1-GE3	⊛ SIA447DJ-T1-GE3	⇒ SIA447DJ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited